

○経済産業省令第三十四号

外国為替及び外国貿易法（昭和二十四年法律第二百二十八号）第六十九条の五、輸出貿易管理令（昭和二十四年政令第三百七十八号）別表第一及び外国為替令（昭和五十五年政令第二百六十号）別表の規定に基づき、輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。

令和7年4月3日

経済産業大臣 武藤 容治

輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令

輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令（平成三年通商産業省令第四十九号）の一部を次の表のように改正する。

（傍線部分は改正部分）

改正後

改正前

(輸出貿易管理令別表第一関係)

第一条 輸出貿易管理令(以下「輸出令」という

。) 別表第一の二の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

一〜九 (略)

十 重水素若しくは重水素化合物の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であつて、次のいずれかに該当するもの

イ (略)

ロ 重水の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であつて、次のい

(輸出貿易管理令別表第一関係)

第一条 輸出貿易管理令(以下「輸出令」という

。) 別表第一の二の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

一〜九 (略)

十 重水素若しくは重水素化合物の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であつて、次のいずれかに該当するもの

イ (略)

ロ 重水の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であつて、次のい

れかに該当するもの（イに該当するものを除く。）

(一) (略)

(二) 低温で用いられる蒸留塔であつて、次の1から4までの全てに該当するもの

1 オーステナイト系ステンレス鋼又はこれと同等の材料であつて、零下二五八度以上零下二三八度以下の温度範囲において水素ぜい性のないものを用いたもの

2 (略)

3 温度が零下二五八度以上零下二三八

れかに該当するもの（イに該当するものを除く。）

(一) (略)

(二) 低温で用いられる蒸留塔であつて、次の1から4までのすべてに該当するもの

1 細粒ステンレス鋼であつて、水素ぜい性のないものを用いたもの

2 (略)

3 温度が零下二三八度以下で用いるこ

度以下で用いることができるように設計したもの

4 ○・一メガパスカル以上一メガパスカル以下の圧力範囲において用いることができるように設計したもの

(三) 真空蒸留用の塔に用いることができるように設計した充填物であつて、化学的にぬれ性を改善する処理を行つたり、ん青銅製のものうち、メッシュ状のもの

(四) ～(六) (略)

十の二～二十一 (略)

二十二 ガス遠心分離機のロータに用いられる

とができるように設計したもの

4 ○・五メガパスカル以上五メガパスカル以下の圧力範囲において用いることができるように設計したもの

(三) 真空蒸留用の塔に用いることができるように設計した充てん物であつて、化学的にぬれ性を改善する処理を行つた隣青銅製のものうち、メッシュ状のもの

(四) ～(六) (略)

十の二～二十一 (略)

二十二 ガス遠心分離機のロータに用いられる

構造材料であつて、次のいずれかに該当するもの

イ (略)

ロ 炭素繊維、アラミド繊維若しくはガラス繊維、炭素繊維若しくはガラス繊維を使用したプリプレグ又は炭素繊維若しくはアラミド繊維を使用した成型品であつて、次のいずれかに該当するもの

(一) ～ (三) (略)

(四) (一) に該当する繊維又は (三) に該当するプリプレグ (炭素繊維を使用したものに限る。)を用いた円筒形の成型品であつて、内径が七五ミリメートル

構造材料であつて、次のいずれかに該当するもの

イ (略)

ロ 炭素繊維、アラミド繊維若しくはガラス繊維、炭素繊維若しくはガラス繊維を使用したプリプレグ又は炭素繊維若しくはアラミド繊維を使用した成型品であつて、次のいずれかに該当するもの

(一) ～ (三) (略)

(四) (一) に該当する繊維又は (三) に該当するプリプレグ (炭素繊維を使用したものに限る。)を用いた円筒形の成型品であつて、内径が七五ミリメートル

超六五〇ミリメートル未満、かつ、厚さ

が一二ミリメートル以下のもの

ハ・ニ (略)

二十三〜五十八 (略)

五十九 水からトリチウムを回収するため又は重水を製造（精製を含む。）するため白金を用いた疎水性の触媒であつて、水素と水との間で行われる水素の同位体交換を促進するために設計したもの

六十〜六十二 (略)

第二条 輸出令別表第一の三の項（一）の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

超四〇〇ミリメートル未満のもの

ハ・ニ (略)

二十三〜五十八 (略)

五十九 重水からトリチウムを回収するため又は重水を製造するための白金を用いた触媒であつて、水素と水との間で行われる水素の同位体交換を促進するために設計したもの

六十〜六十二 (略)

第二条 輸出令別表第一の三の項（一）の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一 軍用の化学製剤の原料となる物質として、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を含む混合物であつて、いずれかの物質の含有量が全重量の三〇パーセントを超えるもの

イ〜イイ (略)

イロ | ジプロピルアミン

二・三 (略)

2 輸出令別表第一の三の項(二)の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

一〜十 (略)

十一 空気中の物質を検知する装置であつて、

一 軍用の化学製剤の原料となる物質として、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を含む混合物であつて、いずれかの物質の含有量が全重量の三〇パーセントを超えるもの

イ〜イイ (略)

(新設)

二・三 (略)

2 輸出令別表第一の三の項(二)の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

一〜十 (略)

十一 空気中の物質を検知する装置であつて、

次のいずれかに該当するもの

イ 前項に掲げるものについて空気中において検知できる最小検出限界が一立方メートル当たり〇・三ミリグラム未満であり、かつ、連続して使用するように設計したものである。

ロ (略)

十二 (略)

3 (略)

第二条の二 輸出令別表第一の三の二の項(一)の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一・二 (略)

次のいずれかに該当するもの

イ 前項に掲げるものについて空気中における濃度が一立方メートル当たり〇・三ミリグラム未満であつても検知することができないものであり、かつ、連続して使用するように設計したものである。

ロ (略)

十二 (略)

3 (略)

第二条の二 輸出令別表第一の三の二の項(一)の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一・二 (略)

三 毒素（免疫毒素を除く。）であつて、アフ
ラトキシシン、アブリン、ウエルシユ菌毒素（
アルファ、ベータ1、ベータ2、イプシロン
又はイオタの毒素に限る。）、HT—2トキ
シン、黄色ブドウ球菌毒素（腸管毒素、アル
ファ毒素及び毒素性ショック症候群毒素）、
ゴニオトキシシン、コノトキシシン、ジアセトキ
シスシルペノール、志賀毒素、T—2トキシ
シン、テトロドトキシシン、ネオサキシトキシシン
、ノジュラリン、パリトキシシン、ビスカミン
、ブレベトキシシン、ボツリヌス毒素、ボルケ
ンシン、ミクロシスチン又はモデシン

四〇六（略）

三 毒素（免疫毒素を除く。）であつて、アフ
ラトキシシン、アブリン、ウエルシユ菌毒素（
アルファ、ベータ1、ベータ2、イプシロン
又はイオタの毒素に限る。）、HT—2トキ
シン、黄色ブドウ球菌毒素（腸管毒素、アル
ファ毒素及び毒素性ショック症候群毒素）、
ゴニオトキシシン、コノトキシシン、ジアセトキ
シスシルペノール、志賀毒素、T—2トキシ
シン、テトロドトキシシン、ノジュラリン、パリ
トキシシン、ビスカミン、ブレベトキシシン、ボ
ツリヌス毒素、ボルケンシン、ミクロシスチ
ン又はモデシン

四〇六（略）

2 (略)

第四条 輸出令別表第一の五の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

一 三 (略)

四 繊維又はこれを使用したプリプレグ、プリフォーム若しくは成型品の製造用の装置であつて、次のいずれかに該当するもの又はその部分品若しくは附属品（第三条第十一号に該当するものを除く。）

イ 八 (略)

ニ 第十五号に該当する繊維を製造するため、次に特に設計又は改造した装置であつて、次

2 (略)

第四条 輸出令別表第一の五の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする

一 三 (略)

四 第二号、第十五号又は第十四条第一号に該当するものの製造用の装置であつて、次のいずれかに該当するもの又はその部分品若しくは附属品（第三条第十一号に該当するものを除く。）

イ 八 (略)

ニ 繊維の製造用の装置であつて、次のいずれかに該当するもの

のいずれかに該当するもの

(一) ～ (四) (略)

ホ ホットメルト方式によりプリプレグを製造するために特に設計又は改造した装置

へ・ト (略)

五～十五 (略)

十六 粒子の径が六〇マイクロメートル以下のほう素であつて、ほう素の重量比による純度が八五パーセント以上のもの若しくはその混合物、粒子の径が六〇マイクロメートル以下のほう素合金であつて、ほう素の重量比が八五パーセント以上のもの若しくはその混合物、硝酸グアニジン、ニトログアニジン又は五

(一) ～ (四) (略)

ホ ホットメルト方式を用いて第十五号ホに該当するプリプレグを製造する装置

へ・ト (略)

五～十五 (略)

十六 粒子の径が六〇マイクロメートル以下のほう素であつて、ほう素の重量比による純度が八五パーセント以上のもの若しくはその混合物、粒子の径が六〇マイクロメートル以下のほう素合金であつて、ほう素の重量比が八五パーセント以上のもの若しくはその混合物、硝酸グアニジン又はニトログアニジン

ふつ化よう素

第五条 輸出令別表第一の六の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

一〇十一 (略)

十二 金属若しくは合金の部品を製造するために設計された積層造形用の装置であつて、次のイからニまでの全てに該当するもの又はそのために特に設計された部分品

イ 次のいずれかの熱源を有するもの

(一) レーザー

(二) 電子ビーム

(三) 電気放電

第五条 輸出令別表第一の六の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

一〇十一 (略)

(新設)

ロ 次のいずれかの制御されたプロセス環境を有するもの

(一) 不活性ガス

(二) 一〇〇パスカル以下の真空

ハ 次のいずれかの同軸構成又は近軸構成であるインプロセス監視装置を有するもの

(一) 電子式のカメラであって、三八〇ナノメートル超一四、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの

(二) パイロメーターであって、一、〇〇〇度以上の温度を計測するために設計したもの

(三) 放射計又は分光機であつて、三八

〇ナノメートル超三、〇〇〇ナノメートル

以下の波長範囲で最大感度を有するもの

ニハに該当するインプロセス監視装置からのフィードバックに応じて、造形中に熱源のパラメータ、製造経路又は機器設定を修正するように設計された閉ループ制御が可能なもの

第六条 輸出令別表第一の七の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

一 集積回路（モノリシック集積回路、ハイブ

第六条 輸出令別表第一の七の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

一 集積回路（モノリシック集積回路、ハイブ

リッド集積回路、マルチチップ集積回路、膜形集積回路（シリコンオンサファイア集積回路を含む。）、光集積回路、三次元集積回路及びモノリシックマイクロ波集積回路を含む。）であつて、次のいずれかに該当するもの

イ（略）

ロ マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ、マイクロコントローラ、化合物半導体を用いた記憶素子用のもの、アナログデジタル変換用のもの、アナログデジタル変換機能を有しデジタル化されたデータを記録し、若しくは処理することができるもの、デジタルアナログ変換用のもの、信号処

リッド集積回路、マルチチップ集積回路、膜形集積回路（シリコンオンサファイア集積回路を含む。）、光集積回路、三次元集積回路及びモノリシックマイクロ波集積回路を含む。）であつて、次のいずれかに該当するもの

イ（略）

ロ マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ、マイクロコントローラ、化合物半導体を用いた記憶素子用のもの、アナログデジタル変換用のもの、アナログデジタル変換機能を有しデジタル化されたデータを記録し、若しくは処理することができるもの、デジタルアナログ変換用のもの、信号処

理用の電気光学的集積回路若しくは光集積回路、フィールドプログラマブルロジックデバイス、カスタム集積回路（ハからチまで若しくはルからヨまでのいずれかに該当する貨物であるかどうかの判断をすることができるもの又は輸出令別表第一の五から一五までの項の中欄のいずれかに該当する貨物に使用するように設計したものであるかどうかの判断をすることができるものを除く。以下この条において同じ。）、FF Tプロセッサ、スタティック式のラム又は不揮発性メモリーであつて、次のいずれかに該当するもの（民生用の自動車又は鉄道

理用の電気光学的集積回路若しくは光集積回路、フィールドプログラマブルロジックデバイス、カスタム集積回路（ハからチまで若しくはルからカまでのいずれかに該当する貨物であるかどうかの判断をすることができるもの又は輸出令別表第一の五から一五までの項の中欄のいずれかに該当する貨物に使用するように設計したものであるかどうかの判断をすることができるものを除く。以下この条において同じ。）、FF Tプロセッサ、スタティック式のラム又は不揮発性メモリーであつて、次のいずれかに該当するもの（民生用の自動車又は鉄道

車両用に設計した集積回路を除く。）

(一) ～ (三) (略)

ハスト (略)

チ ニューラルネットワークを用いたもの

ヨに該当するものを除く。）

リカ (略)

ヨ 揮発性メモリを含まない他の集積回路と

の間の全ての入力及び出力にわたる双方向

の転送速度の総計が六〇〇ギガバイト毎秒

以上である集積回路であって、次のいずれ

かに該当するもの又はこれらに該当するよ

うにプログラムが可能なもの

(一) 合計処理性能 (TPP) が六、〇

車両用に設計した集積回路を除く。）

(一) ～ (三) (略)

ハスト (略)

チ ニューラルネットワークを用いたもの

リカ (略)

(新設)

〇〇以上である機械語命令を実行するデジタルプロセッサユニットを一つ以上有するもの

(二) (一)で指定された機械語命令の実行に寄与するユニットを除き、合計処理性能(TPP)が六、〇〇〇以上であるデジタル基本演算ユニットを一つ以上有するもの

(三) 合計処理性能(TPP)が六、〇〇〇以上であるアナログ基本演算ユニットを一つ以上有するもの

(四) (一)から(三)までのデジタルプロセッサユニットと基本演算ユニット

の組み合わせであって、それらの合計処
理性能 (TPP) の総和が六、〇〇〇以
上であるものを有するもの

二 マイクロ波用機器又はミリ波用機器の部分
品であって、次のいずれかに該当するもの

イ ーチ (略)

リ ハーモニクミキサ又はコンバータであ
って、次のいずれかに該当するもの

(一) スペクトラムアナライザの周波
数帯域を一〇ギガヘルツ超に拡張する
ように設計したもの

(二) 信号発生器の動作範囲を拡張する
ように設計したものであって、次のい

二 マイクロ波用機器又はミリ波用機器の部分
品であって、次のいずれかに該当するもの

イ ーチ (略)

リ ハーモニクミキサ又はコンバータであ
って、次のいずれかに該当するもの

(一) スペクトラムアナライザの周波
数帯域を九〇ギガヘルツ超に拡張するよ
うに設計したもの

(二) 信号発生器の動作範囲を拡張する
ように設計したものであって、次のい

れかに該当するもの

1 周波数帯域が一一〇ギガヘルツを超えるもの

2 周波数帯域が四三・五ギガヘルツ超

一一〇ギガヘルツ以下であって、出力が一〇〇ミリワット（二〇デীবೀエム）を超えるもの

(三) ネットワークアナライザの動作範囲を拡張するように設計したものであつて、次のいずれかに該当するもの

1 (略)

2 周波数帯域が四三・五ギガヘルツ超

一一〇ギガヘルツ以下であつて、出力

れかに該当するもの

1 周波数帯域が九〇ギガヘルツを超えるもの

2 周波数帯域が四三・五ギガヘルツ超

九〇ギガヘルツ以下であつて、出力が一〇〇ミリワット（二〇デীবೀエム）を超えるもの

(三) ネットワークアナライザの動作範囲を拡張するように設計したものであつて、次のいずれかに該当するもの

1 (略)

2 周波数帯域が四三・五ギガヘルツ超

九〇ギガヘルツ以下であつて、出力が

が一〇〇ミリワット(二〇デイベー

エム)を超えるもの

(削る)

(四) (略)

又々カ (略)

ヨ| パラメトリック信号増幅器であつて、次

の(一)から(三)までの全てに該当する
もの

(一) 零下二七二・一五度未満の温度で

作動するように設計したもの

三一・六二ミリワット(一五デイベー

ーエム)を超えるもの

3| 周波数帯域が九〇ギガヘルツ超一一

〇ギガヘルツ以下であつて、出力が一

ミリワット(〇デイベーエム)を超
えるもの

(四) (略)

又々カ (略)

(新規)

(二) 動作周波数が二ギガヘルツ超一五ギガヘルツ以下で作動するように設計したもの

(三) 動作周波数が二ギガヘルツ超一五ギガヘルツ以下かつ零下二七二・一五度の温度において、雑音指数が〇・〇一五デシベル未満のもの

三〇十一 (略)

十二 スペクトラムアナライザーであつて、次のいずれかに該当するもの

イ (略)

ロ 四三・五ギガヘルツ超一〇ギガヘルツ以下のいずれかの周波数帯域で、表示平均

三〇十一 (略)

十二 スペクトラムアナライザーであつて、次のいずれかに該当するもの

イ (略)

ロ 四三・五ギガヘルツ超九〇ギガヘルツ以下のいずれかの周波数帯域で、表示平均ノ

ノイズレベルがマイナス一六〇デシベル
エム毎ヘルツ未満のもの

ハ 一一〇ギガヘルツを超える周波数を分析
することができるもの

ニ 次の(一)及び(二)に該当するもの

(一) 実時間帯域幅が五二〇メガヘルツ
を超えるもの

(二) 次のいずれかに該当するもの

- 1 ハマイクロ秒以下の長さの信号を、
ギャップ又は窓効果による全振幅から
の減衰が三デシベル未満で、一〇〇パ
ーセントの確率で検出するもの
- 2 周波数マスクトリガー機能を有する

イズレベルがマイナス一五〇デシベルエ
ム毎ヘルツ未満のもの

ハ 九〇ギガヘルツを超える周波数を分析す
ることができるもの

ニ 次の(一)及び(二)に該当するもの

(一) 実時間帯域幅が一七〇メガヘルツ
を超えるもの

(二) 次のいずれかに該当するもの

- 1 一五マイクロ秒以下の長さの信号を
、ギャップ又は窓効果による全振幅か
らの減衰が三デシベル未満で、一〇〇
パーセントの確率で検出するもの
- 2 周波数マスクトリガー機能を有する

ものであつて、八マイクロ秒以下の長さの信号を一〇〇パーセントの確率で捉えるもの

十三 信号発生器であつて、次のいずれかに該当するもの（二以上の水晶発振器の周波数を加算した値、減算した値又はこれらの値を過倍した値によつて出力周波数を規定する装置を除く。）

イ (略)

ロ 四三・五ギガヘルツ超一一〇ギガヘルツ以下のいずれかの周波数帯域で、出力一〇〇ミリワット（二〇デビーエム）を超えるもの

ものであつて、一五マイクロ秒以下の長さの信号を一〇〇パーセントの確率で捉えるもの

十三 信号発生器であつて、次のいずれかに該当するもの（二以上の水晶発振器の周波数を加算した値、減算した値又はこれらの値を過倍した値によつて出力周波数を規定する装置を除く。）

イ (略)

ロ 四三・五ギガヘルツ超九〇ギガヘルツ以下のいずれかの周波数帯域で、出力一〇〇ミリワット（二〇デビーエム）を超えるもの

ハ 次のいずれかに該当するもの

(二) ～ (五) (略)

(六) 七五ギガヘルツ超一一〇ギガヘルツ以下の出力周波数帯域で、五・〇ギガヘルツを超えるいずれかの周波数切換えの所要時間が一〇〇マイクロ秒未満のもの

ニ 搬送波に対する一ヘルツ当たりの単側波帯位相雑音の比が次のいずれかに該当するもの

(一) 三・二ギガヘルツ超一一〇ギガヘルツ以下のいずれかの出力周波数帯域で、動作周波数とオフセット周波数の隔た

ハ 次のいずれかに該当するもの

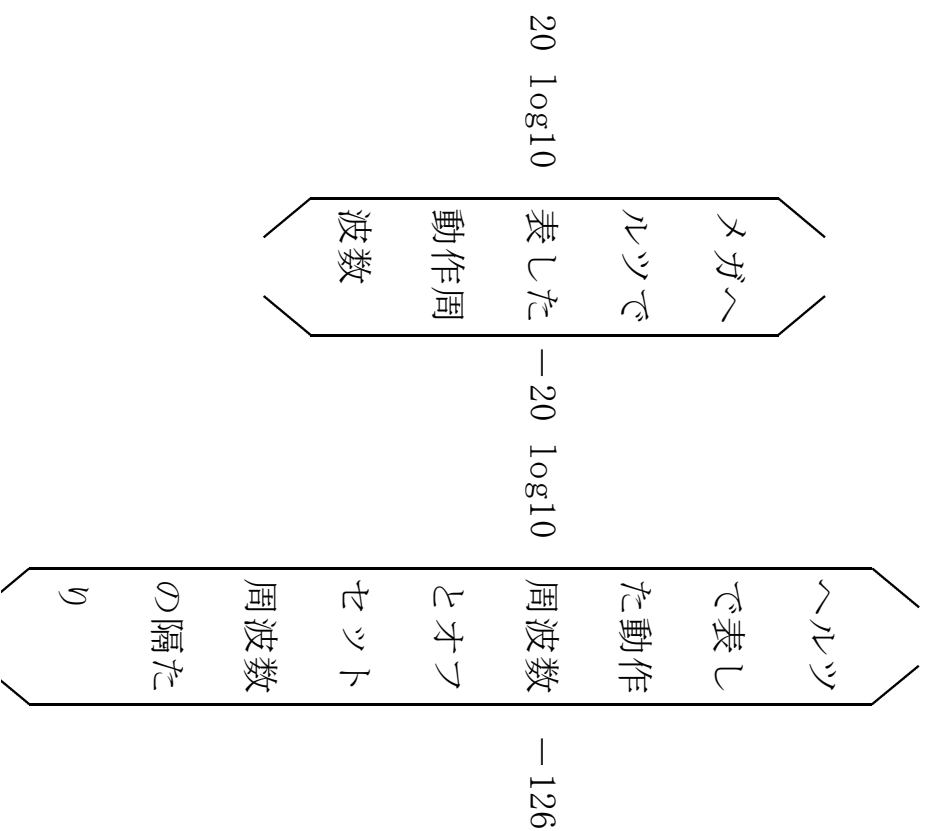
(二) ～ (五) (略)

(六) 七五ギガヘルツ超九〇ギガヘルツ以下の出力周波数帯域で、五・〇ギガヘルツを超えるいずれかの周波数切換えの所要時間が一〇〇マイクロ秒未満のもの

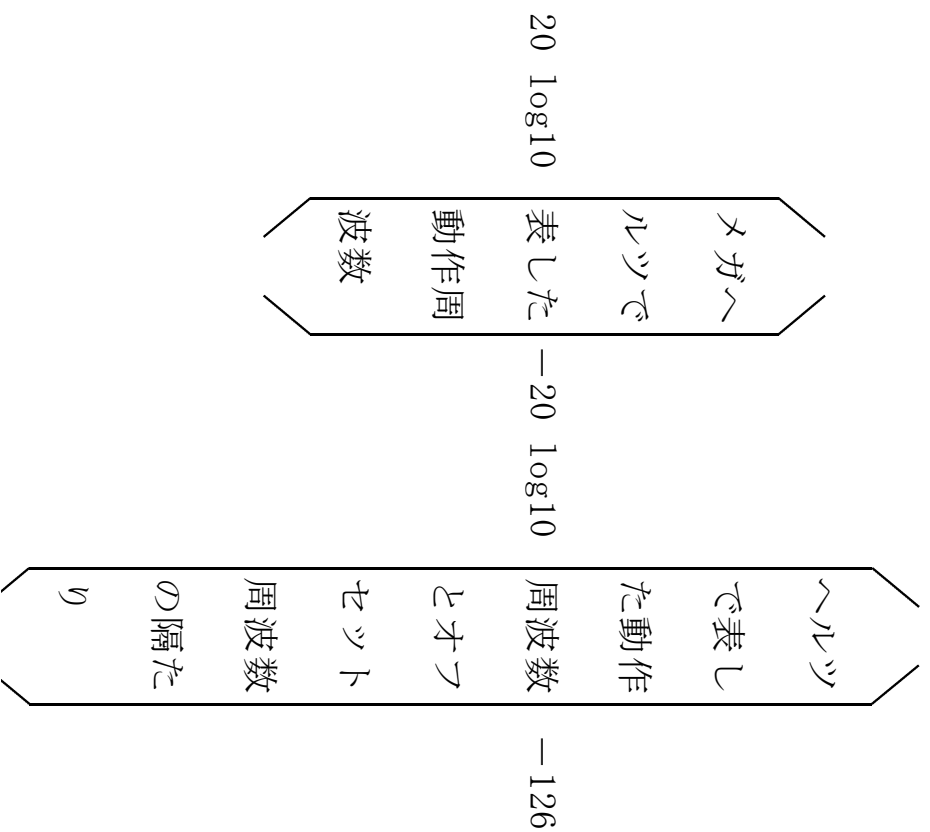
ニ 搬送波に対する一ヘルツ当たりの単側波帯位相雑音の比が次のいずれかに該当するもの

(一) 三・二ギガヘルツ超九〇ギガヘルツ以下のいずれかの出力周波数帯域で、動作周波数とオフセット周波数の隔たり

りが一〇ヘルツ以上一〇キロヘルツ以下のいずれかの周波数帯域において、次に掲げる式により算定した値未満のもの



が一〇ヘルツ以上一〇キロヘルツ以下のいずれかの周波数帯域において、次に掲げる式により算定した値未満のもの



／、
(二) 三・二ギガヘルツ超一〇ギガヘルツ以下のいずれかの出力周波数帯域で、動作周波数とオフセット周波数の隔たりが一〇キロヘルツ超一〇〇キロヘルツ以下のいずれかの周波数帯域において、次に掲げる式により算定した値未満のもの

メガヘルツで	表した	—206
20 log10		
動作周		

／、
(二) 三・二ギガヘルツ超九〇ギガヘルツ以下のいずれかの出力周波数帯域で、動作周波数とオフセット周波数の隔たりが一〇キロヘルツ超一〇〇キロヘルツ以下のいずれかの周波数帯域において、次に掲げる式により算定した値未満のもの

メガヘルツで	表した	—206
20 log10		
動作周		

ホ デジタルベースバンド信号をベクトル変調する機能を有するもので、ベクトル変調帯域幅が次のいずれかに該当するもの

(一) ～ (三) (略)

(四) 七五ギガヘルツ超一一〇ギガヘルツ以下の出力周波数帯域で、五・〇ギガヘルツを超えるもの

へ 最大出力周波数が一一〇ギガヘルツを超えるもの

十四 ネットワークアナライザであって、次

ホ デジタルベースバンド信号をベクトル変調する機能を有するもので、ベクトル変調帯域幅が次のいずれかに該当するもの

(一) ～ (三) (略)

(四) 七五ギガヘルツ超九〇ギガヘルツ以下の出力周波数帯域で、五・〇ギガヘルツを超えるもの

へ 最大出力周波数が九〇ギガヘルツを超えるもの

十四 ネットワークアナライザであって、次

のいずれかに該当するもの

イ 四三・五ギガヘルツ超一〇ギガヘルツ

以下のいずれかの動作周波数帯域において

、出力が一〇〇ミリワット(二〇デイベ

ーエム)を超えるもの

ロ 削除

ハ 五〇ギガヘルツ超一〇ギガヘルツ以下

の周波数帯域における非線形ベクトルの計

測機能を有するもの(イに該当するものを

除く。)

のいずれかに該当するもの

イ 四三・五ギガヘルツ超九〇ギガヘルツ以

下のいずれかの動作周波数帯域において、

出力が三一・六二ミリワット(一五デイベ

ビーエム)を超えるもの

ロ 九〇ギガヘルツ超一〇ギガヘルツ以下

のいずれかの動作周波数帯域において、出

力が一ミリワット(〇デイベーエム)を

超えるもの

ハ 五〇ギガヘルツ超一〇ギガヘルツ以下

の周波数帯域における非線形ベクトルの計

測機能を有するもの(イ又はロに該当する

ものを除く。)

ニ (略)

十五〜十六の二 (略)

十六の三 極低温用の冷却装置又はその部分品であつて、次のいずれかに該当するもの

イ 零下二七三・〇五度以下の温度において、四八時間超にわたつて、六〇〇マイクロワット以上の冷凍出力を供給する定格のもの

ロ 二段式のパルスチューブ冷凍機であつて、温度を零下二六九・一五度未満に維持するものであり、かつ、零下二六八・九五度以下の温度において、一・五ワット以上の冷凍出力を供給する定格のもの

ニ (略)

十五〜十六の二 (略)

(新設)

十七 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置（ホ及びレにおいて「半導体製造装置」という。）若しくは試験装置であつて、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品若しくは附属品

イ 結晶のエピタキシャル成長装置であつて、次のいずれかに該当するもの（ウに該当するものを除く。）

(一) (略)

(二) 有機金属化学的気相成長反応炉であつて、アルミニウム、ガリウム、イン

十七 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置（ホ及びレにおいて「半導体製造装置」という。）若しくは試験装置若しくは集積回路の製造用のマスク若しくはレチクルであつて、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品若しくは附属品（次号に該当するものを除く。）

イ 結晶のエピタキシャル成長装置であつて、次のいずれかに該当するもの（ウに該当するものを除く。）

(一) (略)

(二) 有機金属化学的気相成長反応炉であつて、アルミニウム、ガリウム、イン

ジウム、砒素、りん、アンチモン、酸素
又は窒素のいずれか二以上の元素を有す
る化合物半導体をエピタキシャル成長さ
せるもの

(三) (略)

ロウホ (略)

へ リソグラフィ装置であつて、次のいづれ
かに該当するもの

(一) (略)

(二) インプリントリソグラフィ装置で
あつて、四五ナノメートル以下の線幅を
実現することができるもの(テに該当す
るものを除く。)

ジウム、砒素、燐、アンチモン又は窒素
のいずれか二以上の元素を有する化合物
半導体をエピタキシャル成長させるもの

(三) (略)

ロウホ (略)

へ リソグラフィ装置であつて、次のいづれ
かに該当するもの

(一) (略)

(二) インプリントリソグラフィ装置で
あつて、四五ナノメートル以下の線幅を
実現することができるもの

(三)・(四) (略)

ト|
削|
除|

チ|
削|
除|

リ|
削|
除|

(三)・(四) (略)

ト| マスク又はレチクルであつて、第一号か
ら第八号の四までのいずれかに該当する集
積回路の製造用のもの

チ| 位相シフト膜を有する多層マスクであつ
て、光源の波長が二四五ナノメートル未満
のリソグラフィ装置に用いるために設計し
たもの（トに該当するもの及び第一号から
第八号の四までのいずれにも該当しない記
憶素子を製造するために設計したものを除
く。）

リ| インプリントリソグラフィテンプレート
であつて、第一号から第八号の四までのい

又、ワ (略)

カ ドライエッチング用に設計した装置であつて、次のいずれかに該当するもの

(一) (略)

(二) 異方性ドライエッチング用に設計し、又は改造した装置であつて、次の全てに該当するもの (ア (一) 又はサに該当するものを除く。)

1 (略)

2 切替時間が五〇〇ミリ秒未満の高速ガス切替弁を一以上有するもの

3 静電チャック (個別に温度を制御す

ずれかに該当する集積回路の製造用のもの

又、ワ (略)

カ ドライエッチング用に設計した装置であつて、次のいずれかに該当するもの

(一) (略)

(二) 異方性ドライエッチング用に設計し、又は改造した装置であつて、次の全てに該当するもの

1 (略)

2 切替時間が三〇〇ミリ秒未満の高速ガス切替弁を一以上有するもの

3 静電チャック (個別に温度を制御す

ることができる領域を一〇以上有するものに限る。)を有するもの

ヨ (略)

タ 異方性エッチング用に設計した装置であつて、誘電体の材料に対して、エッチングの幅に対する深さの比率が三〇倍を超え、かつ、当該幅の寸法が一〇〇ナノメートル未満の形状を形成することができるものうち、次の全てに該当するもの (カ (二) ヲ、ア (一) 又はサに該当するものを除く。)

(一) 高周波のパルス出力の電源を一以上有するもの

ることができる領域を二〇以上有するものに限る。)を有するもの

ヨ (略)

タ 異方性エッチング用に設計した装置であつて、誘電体の材料に対して、エッチングの幅に対する深さの比率が三〇倍を超え、かつ、当該幅の寸法が一〇〇ナノメートル未満の形状を形成することができるものうち、次の全てに該当するもの (カ又はヨに該当するものを除く。)

(一) 高周波のパルス出力の電源を一以上有するもの

(二) 切替時間が三〇〇ミリ秒未満の高速ガス切替弁を一以上有するもの

レ 半導体製造装置のうち、成膜装置であつて、次のいずれかに該当するもの

(一)・(二) (略)

(三) 単一のチャンバー内での複数の工程によつて金属のコンタクト層を成膜するように設計した装置であつて、次の全てに該当するもの (二) に該当するものを除く。

1 (略)

2 水素、水素と窒素の混合物又はアンモニアを用いたプラズマにより表面処

(二) 切替時間が三〇〇ミリ秒未満の高速ガス切替弁を一以上有するもの

レ 半導体製造装置のうち、成膜装置であつて、次のいずれかに該当するもの

(一)・(二) (略)

(三) 単一のチャンバー内での複数の工程によつて金属のコンタクト層を成膜するように設計した装置であつて、次の全てに該当するもの (二) に該当するものを除く。

1 (略)

2 水素(水素と窒素又はアンモニアと混合物を含む。)を用いたプラズマ

理を行う工程を有するもの

(四) 半導体製造装置であつて、複数のチャンバー又はステーション内での複数の工程によつて成膜するように設計したものの(以下「特定半導体製造装置」という。)のうち、次に掲げる全ての工程により金属のコンタクト層を成膜するように設計したもの(二)に該当するものを除く。)

1) 3) (略)

による工程を有するもの

(四) 半導体製造装置であつて、複数のチャンバー又はステーション内での複数の工程によつて成膜するものであり、かつ、複数の工程間において○・○一パスカ以下以下の真空状態又は不活性の環境を維持することができるように設計したものの(以下「特定半導体製造装置」という。)のうち、次に掲げる全ての工程により金属のコンタクト層を成膜するように設計したもの(二)に該当するものを除く。)

1) 3) (略)

(五) ～ (十) (略)

ソ 特定半導体製造装置のうち、金属の層を成膜するように設計した装置であって、次の全てに該当するもの (レ) (二) に該当するものを除く。)

(一) ・ (二) (略)

ツ 特定半導体製造装置のうち、金属の層を成膜するように設計した装置であって、次のいずれかに該当するもの (レ) (二) に該当するものを除く。)

(一) ・ (二) (略)

(五) ～ (十) (略)

ソ ○・○一パスカル以下の真空状態又は不活性ガスの環境において金属の層を成膜するように設計した装置であって、次の全てに該当するもの (レ) (二) に該当するものを除く。)

(一) ・ (二) (略)

ツ ○・○一パスカル以下の真空状態又は不活性ガスの環境において金属の層を成膜するように設計した装置であって、次のいずれかに該当するもの (レ) (二) に該当するものを除く。)

(一) ・ (二) (略)

ネ・ナ (略)

ラ 成膜装置であつて、次のいずれかに該当するもの(キ(三)に該当するものを除く

。)

(一)・(二) (略)

ム (略)

ウ シリコン又はシリコンゲルマニウムのエ
ピタキシャル成長用に設計した装置であつ
て、次の全てに該当するもの

(削る)

ネ・ナ (略)

ラ 成膜装置であつて、次のいずれかに該当するもの

(一)・(二) (略)

ム (略)

ウ シリコン(炭素を添加したものを含む。
)|又はシリコンゲルマニウム(炭素を添加
したものを含む。)のエピタキシャル成長
用に設計した装置であつて、次の全てに該
当するもの

(一) | 複数のチャンバーを有し、かつ、
複数の工程間において〇・〇ーパスカル

(一)・(二) (略)

キ 厚さが二マイクロメートル超であり、かつ、密度が一立方センチメートル当たり一・七グラム超のカーボンハードマスクをプラズマを用いた化学的気相成長法により成膜するように設計した装置

ノ (略)

オ 金属配線間の隙間（幅が二五ナノメートル未満であり、かつ、当該幅に対する深さの比率が一倍以上のものに限る。）に比誘

以下の真空状態又は水と酸素の分圧が〇・〇一パスカル未満の不活性な環境を維持することができるもの

(一)・(三) (略)

キ 厚さが一〇〇ナノメートル超であり、かつ、応力が四五〇メガパスカル未満のカーボンハードマスクをプラズマを用いた化学的気相成長法により成膜するように設計した装置

ノ (略)

オ 金属配線間の隙間（幅が二五ナノメートル未満であり、かつ、当該幅に対する深さの比率が一倍以上のものに限る。）に比誘

電率が三・三未満の低誘電層を空隙が生じ
ないようにプラズマを用いて成膜するよう
に設計した装置（キ（三）に該当するもの
を除く。）

クゝフ（略）

コ プラズマドーピング用に設計されたイオ
ン注入装置のうち、次の全てに該当するも
の

（一） 高周波の出力の電源を一以上有す
るもの

（二） パルス直流電源を一以上有するも
の

（三） 少なくともN型又はP型のいずれ

電率が三・三未満の低誘電層を空隙が生じ
ないようにプラズマを用いて成膜するよう
に設計した装置

クゝフ（略）

（新設）

かの不純物の注入が可能なもの

エ| 深紫外液浸フオトリソグラフィ装置にお

いて、又は、深紫外液浸フオトリソグラフィ

装置とともに、次のいずれかを実施する

ように設計又は改造した装置

(一) 次の全てに該当するもの

1| 深紫外液浸フオトリソグラフィ装置

のナノメートルで表した光源の波長に

○・二五を乗じて得た数値を開口数の

値で除して得た数値を四五以下に減少

させるもの

2| 深紫外液浸フオトリソグラフィ装置

の重ね合わせ精度を二・四ナノメートル

(新設)

ル以下にするもの

(二) へ(一) 2又はヲに該当する露光

装置の任意の時間間隔における一時間当たりのウエハーを処理する枚数を平均で一パーセント以上増加させるように設計又は改造したもの

テ| インプリントリソグラフィ装置であつて

、四・〇ナノメートル以下の重ね合わせ精度を有するもの

ア| エッチング用に設計した装置であつて、

次のいずれかに該当するもの

(一) 異方性ドライエッチング用に設計した装置であつて、次の全てに該当する

(新設)

(新設)

もの

1 | 二以上の独立した高周波の電源を有するもの

2 | 二以上の独立したガスの供給源を有するもの

3 | ウエハーの厚みの不均一性を補正するためのプロセス均一性調整機能を有するもの

4 | シリコン貫通電極の露出工程の終点検出の機能を有するもの

(二) 異方性エッチング用に設計した装置であつて、誘電体の材料に対して、エッチングの幅に対する深さの比率が高い

-
- 形状を形成することができるとのうちの、次の全てに該当するもの（カ（二）、ヨ、タ、ア（一）又はサに該当するものを除く。）
- 1 エッチングの幅に対する深さの比率が三〇を超えるもの
- 2 エッチングの幅の上面の寸法が四〇ナノメートル未満のもの
- （三） シリコン貫通電極を作るためのエッチングに用いるために設計した装置であつて、次の全てに該当するもの（カ、ヨ、タ、ア（一）又はア（二）に該当するものを除く。）
-

-
- 1| シリコンのエッチング速度が一分につき七マイクロメートルを超えるもの
 - 2| ウエハー内のエッチングの深さの不均一性が二パーセント以下のもの
 - 3| シリコン貫通電極のアスペクト比が一〇以上のもの

サ| 極端紫外パターンシェイピング用に設計

した装置（カ（一）、ヨ又はア（一）に該当するものを除く。）

キ| 半導体製造装置のうち、成膜装置であつて、次のいずれかに該当するもの

（一） タングステンの膜を物理的气相成長法により成膜する装置であつて、イオ

（新設）

（新設）

インフラックス誘導用の電磁石を有し、アスペクト比を三以上の形状に対して成膜するために特別に設計したもの

(二) モリブデン若しくはルテニウム又はモリブデンとルテニウムを組み合わせた膜を原子層堆積法により成膜するように設計又は改造した装置であつて、次の全てに該当するもの（ネに該当するものを除く。）

1 七五度を超える温度で動作するように設計又は改造した金属前駆体の供給源を有するもの

2 四キロパスカル以上の圧力で水素を

含む還元剤を使用するプロセスチャンネルを有するもの

(三) プラズマ又はラジカルを用いた化学的气相成長法により成膜するように設計した装置であつて、基板の温度を五〇〇度未満に維持しながら、誘電体膜を単一の装置上で紫外線による硬化を行うもののうち、次の全てに該当する誘電体膜を成膜できるもの

1 六ナノメートル超二〇ナノメートル未満の厚さの金属形状であつて、二四ナノメートル未満のピッチを有し、かつ、一・八以上のアスペクト比を有す

るもの

2 | 三・〇未満の比誘電率を有するもの

(四) 炭素材料を化学的気相成長法により成膜するように設計した装置であつて、密度が一立方センチメートル当たり一・六グラムを超える材料を用いたもの（牛に該当するものを除く。）

(五) 二種類以上の金属前駆体を直接液体注入する成膜装置であつて、単一の成膜用のチャンバー内に、幅に対する深さの比率が五〇倍を超える形状に、比誘電率が三五を超える等方的誘電体膜を成膜するように設計又は改造したもの

ユ 三〇〇ミリメートルウエハー用に設計し

(新設)

たアニール装置であつて、ウエハーを一、

〇〇〇度を超える温度で、二ミリ秒未満の

持続時間で加熱できるように設計したもの

メ 超臨界二酸化炭素又は昇華乾燥を用いる

(新設)

ように設計した枚葉式のウエハー洗浄装置

ミ 直径三〇〇ミリメートル以上のウエハー

(新設)

を受け入れるように設計又は改造した。パタ

ーン付きウエハー欠陥測定装置又はパター

ン付きウエハー欠陥検査装置であつて、次

の全てに該当するもの

(一) 二一ナノメートル以下の大きさの

欠陥を検出するように設計又は改造した

もの

(二) 次のいずれかを有するもの

1 波長が四〇〇ナノメートル未満の光源

2 分解能が一・六五ナノメートル以下の電子ビーム源

3 ビーム冷陰極電界放出型の電子ビーム源

4 二以上の電子ビーム源

シ 計測装置であつて、次のいずれかに該当するもの

(一) 露光前にウエハー形状パラメータを測定し、開口数一・三超の液浸レンズ

(新設)

を有する深紫外リソグラフィ装置又は極端紫外リソグラフィ装置の重ね合わせ誤差又はフォーカスを改善するために測定値を利用するように設計したスタンドアロン装置

(二) 画像ベースの重ね合わせ誤差又は回折ベースの測定技術を用いて、製品ウエハー上のレジスト現像後又はエッチング後のフォーカス又は重ね合わせ誤差を測定するように設計した測定装置で、○
・五ナノメートル以下の重ね合わせ誤差測定精度を有するものであつて次のいずれかを有するもの

1 | トラックへの組み込み用に設計され
たもの

2 | 高速波長切り替え機能を有するもの

十七の二 | 半導体素子、集積回路又は半導体物
質の製造用の装置又は試験装置であつて、次
のいずれかに該当するもの

イ | 半導体素子又は集積回路の画像を取得す
るために設計した走査型電子顕微鏡であつ
て、次の（一）から（七）までの全てに該
当するもの（国際半導体製造装置材料協会
が定めたSEMI規格に準拠したウエハー
の搬送・保管容器（二〇〇ミリメートル以
上のフロント・オープニング・ユニファイ

十七の二 | ペリクルであつて、極端紫外を用い
て集積回路を製造するための装置用に特に設
計したもの

ド・ポッド (FOUP) を含む。) 用にウ
エハー搬入部を設計したものを除く。)

(一) ステージの位置決め精度が三〇ナ
ノメートル未満のもの

(二) レーザー干渉計によるステージ位
置計測が可能なもの

(三) レーザー干渉計による長さスケー
ル計測に基づく視野の位置校正が可能
なもの

(四) 画素数が二〇〇、〇〇〇、〇〇〇
を超える画像の収集及び保存が可能
なもの

(五) 画像を取得する際の視野の重なり

が垂直方向及び水平方向で五パーセント
未満のもの

(六) 画像を結合する際の視野の重なり
が五〇ナノメートル未満のもの

(七) 加速電圧が二一キロボルトを超え
るもの

ロ 極低温ウエハープローバ装置であつて、
次の(一)及び(二)に該当するもの

(一) 零下二六八・六五度以下の温度で
試験を行うことができるように設計した
もの

(二) 直径が一〇〇ミリメートル以上の
ウエハーに対応するように設計したもの

十七の三 集積回路の製造用のマスク若しくは

レチクル又はこれらの部分品若しくは附属品であつて、次のいずれかに該当するもの

イ マスク又はレチクル（二に該当するものを除く。）であつて、第一号から第八号の四までのいずれかに該当する集積回路の製造用のもの又はこれらの部分品若しくは附属品（ホに掲げるものを除く。）

ロ 位相シフト膜を有する多層マスクであつて、光源の波長が二四五ナノメートル未満のリソグラフィ装置に用いるために設計したもの（イに該当するもの及び第一号から第八号の四までのいずれにも該当しない記

（新設）

憶素子を製造するために設計したものを除く。）又はその部分品若しくは附属品

ハ インプリントリソグラフィテンプレートであつて、第一号から第八号の四までのいずれかに該当する集積回路の製造用のもの又はその部分品若しくは附属品

ニ 極端紫外を用いて集積回路を製造するための装置用に特に設計したマスク又はレチクルであつて、次号に該当するマスクブラックを有するもの又はこれらの部分品若しくは附属品（ホに掲げるものを除く。）

ホ ペリクルであつて、極端紫外を用いて集積回路を製造するための装置用に特に設計

したもの

十七の四 (略)

(削る)

十七の三 (略)

十七の四 半導体素子又は集積回路の画像を取得するために設計した走査型電子顕微鏡であって、次のイからトまでの全てに該当するもの(国際半導体製造装置材料協会が定めたSEM規格に準拠したウエハーの搬送・保管容器(二〇〇ミリメートル以上のフロント・オープニング・ユニファイド・ポッド(FOUP)を含む。)用にウエハー搬入部を設計したものを除く。)

イ ステージの位置決め精度が三〇ナノメートル未満のもの

十八 基板であって、当該基板の上に次のい

ロ レーザー干渉計によるステージ位置計測が可能なもの

ハ レーザー干渉計による長さスケール計測に基づく視野の位置校正が可能なもの

ニ 画素数が二〇〇、〇〇〇、〇〇〇〇を超える画像の収集及び保存が可能なもの

ホ 画像を取得する際の視野の重なりが垂直方向及び水平方向で五パーセント未満のもの

ヘ 画像を結合する際の視野の重なりが五〇ナノメートル未満のもの

ト 加速電圧が二一キロボルトを超えるもの

十八 基板であって、当該基板の上に次のい

れかに該当する物質の多層膜の結晶を有し、かつ、当該結晶がエピタキシャル成長されているものうち、ヘテロエピタキシャル材料となるもの（次号に該当するもの又は二に該当する化合物（窒化ガリウム、窒化インジウムガリウム、窒化アルミニウムガリウム、窒化インジウムアルミニウム、窒化インジウムアルミニウムガリウム、リン化ガリウム、砒化ガリウム、砒化アルミニウムガリウム、リン化インジウム、リン化インジウムガリウム、リン化アルミニウムインジウム又はリン化インジウムガリウムアルミニウムに限る。）のP型エピタキシャル層を一層以上有するも

れかに該当する物質の多層膜の結晶を有し、かつ、当該結晶がエピタキシャル成長されているものうち、ヘテロエピタキシャル材料となるもの（二に該当する化合物（窒化ガリウム、窒化インジウムガリウム、窒化アルミニウムガリウム、窒化インジウムアルミニウム、窒化インジウムアルミニウムガリウム、リン化ガリウム、砒化ガリウム、砒化アルミニウムガリウム、リン化インジウム、リン化インジウムガリウム、リン化アルミニウムインジウム又はリン化インジウムガリウムアルミニウムに限る。）のP型エピタキシャル層を一層以上有するものであって、当該P型エ

のであつて、当該P型エピタキシャル層がN型層に挟まれていないものを除く。）

イゝへ (略)

十八の二 基板であつて、当該基板の上に次のいずれかに該当する物質の一層以上からなる膜の結晶を有し、かつ、当該結晶がエピタキシャル成長されているものうち、エピタキシャル材料となるもの

イ シリコンであつて、シリコン二八又はシリコン三〇以外のシリコンの同位体からなる不純物の割合が〇・〇八パーセント未満のもの

ロ ゲルマニウムであつて、ゲルマニウム七

ピタキシャル層がN型層に挟まれていないものを除く。）

イゝへ (略)

(新設)

○、ゲルマニウム七二、ゲルマニウム七四
又はゲルマニウム七六以外のゲルマニウム
の同位体からなる不純物の割合が〇・〇八
パーセント未満のもの

十九〜二十四 (略)

二十五 シリコン又はゲルマニウムのふつ化物
、水素化物又は塩化物であつて、次のいずれ
かを含むもの

イ シリコンであつて、シリコン二八又はシ
リコン三〇以外のシリコンの同位体からな
る不純物の割合が〇・〇八パーセント未
満のもの

ロ ゲルマニウムであつて、ゲルマニウム七

十九〜二十四 (略)

(新設)

○、ゲルマニウム七二、ゲルマニウム七四
又はゲルマニウム七六以外のゲルマニウム
の同位体からなる不純物の割合が○・○八
パーセント未満のもの

二十六 シリコン、シリコン酸化物、ゲルマニ
ウム又はゲルマニウム酸化物であつて、次の
いずれかを含むもの又はこれらの基板若しく
はインゴット、ブール又はその他のプリフォ
ーム

イ シリコンであつて、シリコン二八又はシ
リコン三〇以外のシリコンの同位体からな
る不純物の割合が○・〇八パーセント未満
のもの

(新設)

ロ ゲルマニウムであつて、ゲルマニウム七

〇、ゲルマニウム七二、ゲルマニウム七四

又はゲルマニウム七六以外のゲルマニウム

の同位体からなる不純物の割合が〇・〇八

パーセント未満のもの

第七条 輸出令別表第一の八の項の経済産業省令

で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

一〇六 (略)

七 電子計算機又はその電子組立品若しくは部

分品であつて、前条第一号ヨに該当する集積

回路を一つ以上有するもの

第八条 輸出令別表第一の九の項の経済産業省令

第七条 輸出令別表第一の八の項の経済産業省令

で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

一〇六 (略)

(新設)

第八条 輸出令別表第一の九の項の経済産業省令

で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

一～八の二 (略)

九 暗号装置又は暗号機能を実現するための部品品であつて、次のイからホまでのいずれかに該当するもの (第三条第十九号ハ (二) 2、本号へ、第十一号又は第十条第五号イに該当するものを除く。)

イ 対称アルゴリズムを用いたものであつて対称鍵の長さが五六ビットを超えるもの又は非対称アルゴリズム (アルゴリズムの安全性が次の (一) から (六) までのいずれかに該当する困難性に基づくものに限る。

で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

一～八の二 (略)

九 暗号装置又は暗号機能を実現するための部品品であつて、次のイからホまでのいずれかに該当するもの (第三条第十九号ハ (二) 2、本号へ、第十一号又は第十条第五号イに該当するものを除く。)

イ 対称アルゴリズムを用いたものであつて対称鍵の長さが五六ビットを超えるもの又は非対称アルゴリズム (アルゴリズムの安全性が次の (一) から (六) までのいずれかに該当する困難性に基づくものに限る。

以下この号において同じ。)を用いたものであつて、データの機密性確保のための暗号機能を有するように設計し、又は改造したもののうち、次の(七)から(十)までのいずれかに該当するもの(十一)から(十八)までに該当するものを除く。)

(二) ～ (十) (略)

(十一) 暗号機能を有するスマートカー

以下この号において同じ。)を用いたものであつて、データの機密性確保のための暗号機能を有するように設計し、又は改造したもの(当該暗号機能を使用することができ、又は安全な仕組みの暗号機能有効化の手段以外の手段で暗号機能の有効化できるものに限る。)のうち、次の(七)から(十)までのいずれかに該当するもの(十一)から(二十)までに該当するものを除く。)

(二) ～ (十) (略)

(十一) 暗号機能を有するスマートカー

ド若しくはそのリーダライタであつて、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品

1 スマートカードであつて、次のいずれかに該当するもの

一 データ機密性確保のための暗号機能が、本号イに該当しない装置又はシステム（本号へのみに該当するものを除く。）に限定して使用されるスマートカードであつて、かつ、他の用途のためにプログラムの書き換えができないもの

（削る）

ド若しくはそのリーダライタであつて、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品

1 スマートカードであつて、次のいずれかに該当するもの

一 次のいずれかに該当するものに限定されて使用するものであつて、他の用途のためにプログラムの書き換えを行うことができないもの

イ（七）から（十）までのいずれ

(削る)

(削る)

二 個人情報（生存する個人に関する情報であつて、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等によ

にも該当しないもの

ロ 対称アルゴリズムを用いたものであつて対称鍵の長さが五六ビットを超えるもの又は非対称アルゴリズムを用いたものであつて、データの機密性確保のための暗号機能^一を有するように設計したものの以外のもの

ハ (十二) から (十六) までに該当するもの

二 個人情報（生存する個人に関する情報であつて、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等によ

り特定個人を識別することができる
もの（他の情報と容易に照合するこ
とができ、それにより特定の個人を
識別することができることとなるも
の（認証及び金銭債権に係るものそ
の他これらに類するものを含む。）
を含む。）をいう。（十一）におい
て同じ。）又は団体情報（法人その
他の団体の情報であつて、認証及び
金銭債権に係るものその他これらに
類するものを含む。（十一）におい
て同じ。）に係る情報が記録され、
又は記録されるように設計したもの

り特定個人を識別することができる
もの（他の情報と容易に照合するこ
とができ、それにより特定の個人を
識別することができることとなるも
の（認証及び金銭債権に係るものそ
の他これらに類するものを含む。）
を含む。）をいう。（十一）におい
て同じ。）又は団体情報（法人その
他の団体の情報であつて、認証及び
金銭債権に係るものその他これらに
類するものを含む。（十一）におい
て同じ。）に係る情報が記録され、
又は記録されるように設計したもの

であつて、次のイからハまでの全てに該当するもの

イ・ロ (略)

ハ 当該スマートカードを使用する者が当該スマートカードの有するデータの機密性確保のための暗号機能を変更することができないもの

2 リーダライタ(電気通信回線を通じて読み取り、又は記録するものを含む)。

であつて、次のイからハまでの全てに該当するもの

イ・ロ (略)

ハ 当該スマートカードを使用する者が当該スマートカードの有する暗号機能を変更することができないもの

2 リーダライタであつて、専ら1に該当するスマートカードに記録された個人情報若しくは団体情報に係る情報を読み取り、又は当該スマートカードに個人情報若しくは団体情報に係る情報

(削る)

(十二)

民生用に設計した携帯用電話機
端末（携帯回線網用の電話その他の無線
回線網用の電話をいう。（十四）におい
て同じ。）若しくは移動用電話機端末（

を記録するように設計し、又は改造し
たもの（電気通信回線を通じて読み取
り、又は記録するものを含む。）

(十二)

暗号装置であつて、銀行業務若
しくは決済（料金の徴収及び精算又は割
賦販売法（昭和三十六年法律第五十九
号）第二条第三項に規定する包括信用購
入あつせんに係る業務を含む。）に使用
するよう設計したもの又はその部分品

(十三)

民生用の携帯用電話機端末（携
帯回線網用の電話その他の無線回線網用
の電話をいう。（十五）において同じ。
）若しくは移動用電話機端末（専ら自動

専ら自動車その他の移動体において使用するよう設計したものをいう。(十四)において同じ。)であつて、次の1及び2に該当するもの(衛星電話を除く。)

又はこれらの部分品

1・2 (略)

(十三) (略)

(十四) 民生用に設計した携帯用電話機端末若しくは移動用電話機端末又は同等の無線機端末であつて、特定の民生産業用途に用いるために設計を変更したもののうち、次の1及び2に該当するもの又はこれらの部分品

車その他の移動体において使用するよう設計したものをいう。(十五)において同じ。)であつて、次の1及び2に該当するもの又はこれらの部分品

1・2 (略)

(十四) (略)

(十五) 民生用の携帯用電話機端末若しくは移動用電話機端末又は同等の無線機端末であつて、公開された又は商業用の暗号標準(無断の複製を防止するための)のものであつて、公開されていないものを(含む。)のみを用いたものうち、暗号

1| 設計を変更する前の端末が、本号へ
に該当するもの

2| 設計を変更する前の端末のデータの
機密性確保のための暗号機能が、設計
の変更による影響を受けないものであ
って、公開された又は商業用の暗号標

機能が使用者によって変更できず、使用
に際して供給者又は販売店の技術支援が
不要であるように設計したもので、かつ
、特定の民生産業用途に用いるために設
計を変更したもの（暗号機能を変更して
いないものに限る。）又はこれらの部分
品

（新設）

（新設）

準のみを用いたもの

(削る)

(十五)

民生用に設計した移動体通信用の無線アクセスネットワーク装置であつて、暗号機能が使用者によつて変更できず、使用に際して供給者又は販売店の技術支援が不要であるように設計したもののうち、無線周波数の出力が〇・一ワット(二〇デシービーエム)以下で、かつ同時に接続できるデバイスが三二以下

(十六)

無線パーソナルエリアネットワークに用いられる装置であつて、公開された若しくは商業用の暗号標準のみを用いたもの又はその部分品

(十七)

民生用に設計した移動体通信用の無線アクセスネットワーク装置であつて、暗号機能が使用者によつて変更できず、使用に際して供給者又は販売店の技術支援が不要であるように設計したもののうち、無線周波数の出力が〇・一ワット(二〇デシービーエム)以下で、かつ同時に接続できるデバイスが十六以下

のもの又はその部分品

(十六) ルーター、スイッチ、ゲートウ

エイ若しくはリレーであつて、データの

機密性確保のための暗号機能が装置の操

作、管理若しくは保守に関するものに限

定されており、かつ、公開された若しく

は商業用の暗号標準のみを用いたもの又

はこれらの部分品

(十七) 汎用目的の計算機能を有する装

置若しくはサーバーであつて、データの

機密性確保のための暗号機能が次の1及

び2に該当するもの又はこれらの部分品

1・2 (略)

のもの又はその部分品

(十八) ルーター、スイッチ、ゲートウ

エイ若しくはリレーであつて、情報シス

テムのセキュリティ管理機能が装置の操

作、管理若しくは保守に関するものに限

定されており、かつ、公開された若しく

は商業用の暗号標準のみを用いたもの又

はこれらの部分品

(十九) 汎用目的の計算機能を有する装

置若しくはサーバーであつて、情報シス

テムのセキュリティ管理機能が次の1及

び2に該当するもの又はこれらの部分品

1・2 (略)

(十八) ネットワークに接続する民生産

業用途のために設計したものであって、

次の1及び2に該当するもの又はこれらの部分品

1 次のいずれかに該当するもの

一 ネットワークに接続可能な端末で

あって、次のいずれかに該当するも

の

イ データの機密性確保のための暗

号機能が、任意でないデータの秘

匿又は操作、管理若しくは保守に

限定されているもの

ロ (略)

(二十) ネットワークに接続する民生産

業用途のために設計したものであって、

次の1及び2に該当するもの又はこれらの部分品

1 次のいずれかに該当するもの

一 ネットワークに接続可能な端末で

あって、次のいずれかに該当するも

の

イ 情報システムのセキュリティ管

理機能が、任意でないデータの秘

匿又は操作、管理若しくは保守に

限定されているもの

ロ (略)

二 ネットワーク装置であつて、次の
イ及びロに該当するもの

イ (略)

ロ データの機密性確保のための暗
号機能が、一に該当する端末のネ
ットワークに接続する民生産業用
途の支援に限定されているもの、
又は当該ネットワーク装置若しく
は本号イ(十八)に該当する他の
貨物の操作、管理若しくは保守に
限定されているもの

2 データの機密性確保のための暗号機
能が、公開された又は商業用の暗号標

二 ネットワーク装置であつて、次の
イ及びロに該当するもの

イ (略)

ロ 情報システムのセキュリティ管
理機能が、一に該当する端末のネ
ットワークに接続する民生産業用
途の支援に限定されているもの、
又は当該ネットワーク装置若しく
は本号イ(二十)に該当する他の
貨物の操作、管理若しくは保守に
限定されているもの

2 情報システムのセキュリティ管理機
能が、公開された又は商業用の暗号標

準のみを用いたものであつて、当該貨物の有する暗号機能が当該貨物を使用する者によつて変更できないもの

ロゝへ (略)

十ゝ十二 (略)

第十一条 輸出令別表第一の一二の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

一ゝ九 (略)

十 船舶の部分品であつて、次のいずれかに該当するもの

イゝハ (略)

ニ 複合材料を用いた軸を組み込んだ伝動装

準のみを用いたものであつて、当該貨物の有する暗号機能が当該貨物を使用する者によつて変更できないもの

ロゝへ (略)

十ゝ十二 (略)

第十一条 輸出令別表第一の一二の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

一ゝ九 (略)

十 船舶の部分品であつて、次のいずれかに該当するもの

イゝハ (略)

ニ 複合材料を用いた伝動軸装置であつて、

置であつて、十メガワットを超える出力を
伝達するように設計したもの

十一〜十四 (略)

第十二条 輸出令別表第一の一三の項の経済産業
省令で定める仕様のもは、次のいずれかに該
当するものとする。

一〜五 (略)

六 液体ロケット推進装置の部分品であつて、
次のいずれかに該当するもの

イ 極低温用の冷却装置、デユワー瓶、ヒー
トパイプその他の極低温用装置であつて、
極低温状態にある液体の損失が一年間につ
き三〇パーセント未満となるように設計し

二メガワットを超える出力を伝達すること
ができるもの

十一〜十四 (略)

第十二条 輸出令別表第一の一三の項の経済産業
省令で定める仕様のもは、次のいずれかに該
当するものとする。

一〜五 (略)

六 液体ロケット推進装置の部分品であつて、
次のいずれかに該当するもの

イ 極低温用の冷却装置、デユワー瓶、ヒー
トパイプその他の極低温用装置であつて、
宇宙空間用の飛しょう体又はその打上げ用
の飛しょう体を使用するように設計し、か

たもの

ロ 零下一七三・一五度以下の温度を維持又

は生成するように設計された極低温用容器

又は閉サイクル冷却装置

ハクチ (略)

七く二十 (略)

第十七条 外為令別表の五の項(一)の経済産業
省令で定める技術は、次のいずれかに該当する
ものとする。

つ、極低温状態にある液体の損失が一年間
につき三〇パーセント未満のもの

ロ 極低温用容器又は閉サイクル冷却装置で
あつて、零下一七三度以下にすることがで
きるものうち、宇宙空間用の飛しよう体
、打上げ用の飛しよう体又はマツハ数が三
を超える速度での巡航が可能な航空機に使
用することができるように設計したもの

ハクチ (略)

七く二十 (略)

第十七条 外為令別表の五の項(一)の経済産業
省令で定める技術は、次のいずれかに該当する
ものとする。

2 5 6 (略)

7 外為令別表の五の項(八)の経済産業省令で定める技術は、第十四条第二号に該当する電波若しくは赤外線吸収材又は導電性高分子の使用(据付、保守又は修理に係るものに限る。)に係る技術(プログラムを除く。)とする。

第十八条 (略)

2 5 (略)

6 外為令別表の六の項(六)の経済産業省令で定める技術は、次の各号の全てに該当するコーディングシステムの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)とする。

一 第四条第十二号に該当するセラミックマト

2 5 6 (略)

7 外為令別表の五の項(八)の経済産業省令で定める技術は、第十四条第二号に該当する電波の吸収材又は導電性高分子の使用(据付、保守又は修理に係るものに限る。)に係る技術(プログラムを除く。)とする。

第十八条 (略)

2 5 (略)

(新設)

リックス複合材料の腐食を防ぐために設計したもの

二 一、一〇〇度を超える温度で使用することができるよう設計したもの

第十九条 外為令別表の七の項（一）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

一～四 （略）

五 第六条に該当するもの（前二号又は同条第一号、第十六号の三若しくは第十八号から第二十六号までのいずれかに該当するものを除く。）を設計し、又は製造するために設計したプログラム

第十九条 外為令別表の七の項（一）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

一～四 （略）

五 第六条に該当するもの（前二号又は同条第一号若しくは第十八号から第二十四号までのいずれかに該当するものを除く。）を設計し、又は製造するために設計したプログラム

2 外為令別表の七の項(二)の経済産業省令で定める技術は、第六条第十七号イ、ロ、ホ、ヘ又は又からシまでのいずれかに該当するものを使用するために設計したプログラムとする。

3 外為令別表の七の項(三)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

一～八 (略)

九 複数のチップをマルチチップ集積回路に統合するために設計した電子コンピュータ支援設計プログラムであつて、次の全てに該当するもの

(一) フロアプランニングを有するもの

2 外為令別表の七の項(二)の経済産業省令で定める技術は、第六条第十七号イ、ロ、ホ、ヘ又は又からフまでのいずれかに該当するものを使用するために設計したプログラムとする。

3 外為令別表の七の項(三)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

一～八 (略)

(新設)

(二) チップとパッケージの協調設計又は

協調シミュレーションを有するもの

十 マルチパターンニングを使用した集積回路を

設計し、又は製造するために設計し、又は改

造した電子コンピュータ支援設計プログラム

十一 深紫外リソグラフィのマスク又はレチク

ル上のパターンを設計し、又は製造するため

に設計し、又は改造した計算機リソグラフィ

用のプログラム

4・5 (略)

第二十条 外為令別表の八の項(一)の経済産業

省令で定める技術は、次のいずれかに該当する

もの(セキュリティの脆弱性の開示又はサイバ

(新設)

(新設)

4・5 (略)

第二十条 外為令別表の八の項(一)の経済産業

省令で定める技術は、次のいずれかに該当する

もの(セキュリティの脆弱性の開示又はサイバ

―攻撃の対応に係る技術（プログラムを除く。）を除く。）とする。

一 第七条第一号から第五号まで又は第七号のいずれかに該当するものの設計、製造又は使用に必要な技術（プログラムを除く。）

二 第七条第一号から第五号まで又は第七号のいずれかに該当するものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術（プログラムを除く。）

三・四 （略）

2
（略）

―攻撃の対応に係る技術（プログラムを除く。）を除く。）とする。

一 第七条第一号から第五号までのいずれかに該当するものの設計、製造又は使用に必要な技術（プログラムを除く。）

二 第七条第一号から第五号までのいずれかに該当するものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術（プログラムを除く。）

三・四 （略）

2
（略）

附 則

(施行期日)

1 この省令は、令和七年五月二十八日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。